ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК Cu₂S МЕТОДАМИ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ Дронова М.В.

Научный руководитель: к.т.н., доцент кафедры наноматериалов и нанотехнологий Томского политехнического университета Ан В.В.

E-mail: dronova.mariya@mail.ru

Научный интерес к сульфиду меди связан с его особыми оптоэлектрическими свойствами. Для данного материала характерны электрическая металлоподобная проводимость, оптимальные преобразования характеристики солнечной ДЛЯ энергии, ДЛЯ использования в оптических и электрических устройствах. Различные методы получения образцов оказывают существенное влияние на разнообразие стехиометрических форм от Cu₂S до CuS₂ [Жиленко М.П., Эрлих Г.В., Лисичкин Г.В. Получение и модифицирование поверхности наноразмерного сульфида меди // Российские нанотехнологии. – 2009. – №83. – С. 5–6], и как следствие - структуру и морфологию их поверхности. Широкие возможности в исследованиях этой области предоставляет метод атомно-силовой микроскопии. В настоящей работе приведены результаты по АСМ-анализу пленок Си₂S, полученных методом магнетронного распыления.

По результатам анализа видно, что заданный образец характеризуется сильной шероховатостью и неоднородностью поверхности. Об этом свидетельствуют пустоты, находящиеся на

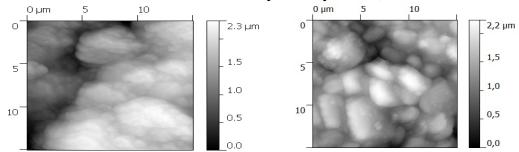


Рисунок 2 – 2D-изображение образца пленки

Рисунок 3 – 2D-изображение подложки

глубине, недоступной для сканирующего зондового датчика. Зерна образца имеют удлиненную форму, их средний размер составляет 2–2,5 мкм.

Средний размер зерен керамики составляет 4 мкм. Суммируя все вышесказанное, пленка Cu_2S , полученная методом магнетронного распыления, повторяет поверхностные свойства керамической подложки. Это говорит о необходимости учета материала подложки при дальнейшем анализе поверхности тонких полупроводниковых образцов.